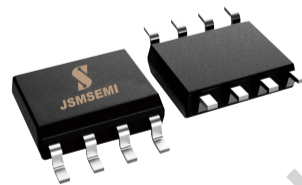


1 产品概述

TF2184M是高压、高速功率MOSFET/IGBT高低侧驱动系列芯片，具有单输入信号同时控制两个传输通道。内部集成了高、低侧欠压锁定电路、过压钳位电路、和防直通锁定电路等保护电路，具备大电流脉冲输出能力，逻辑输入电平兼容低至3.3V的CMOS或LSTTL逻辑输出电平，输出电流能力最大可达4A，其浮地通道最高工作电压可达700V。可用于驱动N沟道高压功率MOSFET/IGBT等器件。TF2184M采用SOP-8封装，可以在-40℃至125℃温度范围内工作。



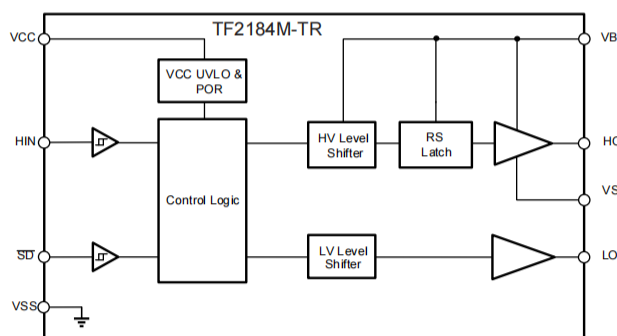
2 产品特性

- 自举工作的浮动通道
 - 最高工作电压为 700 V
 - 兼容 3.3 V, 5V 和 15V 输入逻辑
 - dV/dt 耐受能力可达 ± 50 V/nsec
 - V_s 负压耐受能力达-9V
 - 栅极驱动电压：10 V 到 20V
 - 高、低侧欠压锁定电路
 - 欠压锁定正向阈值 8.9V
 - 欠压锁定负向阈值 8.2V
 - 防直通死区逻辑
 - 内置 400ns 死区时间
 - 芯片开通/关断传输延时
 - $T_{on}/T_{off} = 530ns/130ns$
 - 高低侧延时匹配
 - 驱动电流能力：
 - 拉电流/灌电流=4.0A/4.0A
 - 符合 RoSH 标准
- SOIC8 (S)

3 应用范围

- 电机控制
- 空调/洗衣机
- 通用逆变器
- 微型逆变器驱动程序

简化示意图



4 引脚功能描述

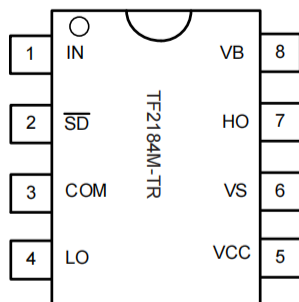


图4-1 8-脚SOIC顶视图

表4-1 芯片引脚描述

编号	名称	功能
1	IN	高侧和低侧信号输入
2	$\overline{SD}$	shutdown 信号输入
3	COM	地
4	LO	低侧输出
5	VCC	电源
6	VS	高侧浮动地
7	HO	高侧输出
8	VB	高侧浮动电源

5 产品规格

5.1 极限工作范围

为了正确地操作，器件应当在以下推荐条件下使用。无特殊说明的情况下，所有电压参数的额定值是以VSS为参考的，电流参数以流入端口为正，环境温度为25℃。

符号	定义	最小值	最大值	单位
V_B	高侧浮动电源电压	-0.3	725	V
V_S	高侧浮动地电压	$V_B - 25$	$V_B + 0.3$	
V_{HO}	高侧输出电压	$V_S - 0.3$	$V_B + 0.3$	
V_{CC}	低侧供电电压	-0.3	25	
V_{LO}	低侧输出电压	-0.3	$V_{CC} + 0.3$	
V_{IN}	逻辑输入电压 ($H_{IN} / I_N, L_{IN} / \overline{L_{IN}} / \overline{SD}$)	-0.3	$V_{CC} + 0.3$	

5.2 ESD 额定值

符号	定义	最小值	最大值	单位
ESD	人体放电模式	1.5	—	kV
	机器放电模式	500	—	V

5.3 额定功率

符号	定义	最小值	最大值	单位
P_D	封装功率 ($T_A \leq 25^\circ\text{C}$)	—	0.625	W

5.4 热量信息

符号	定义	最小值	最大值	单位
R_{thJA}	结到环境的热阻	—	200	$^\circ\text{C} / \text{W}$
T_J	结温	—	150	$^\circ\text{C}$
T_S	存储温度	-55	150	
T_L	引脚温度	—	300	

5.5 推荐工作范围

为了正确地操作，器件应当在以下推荐条件下使用。无特殊说明的情况下，所有电压参数的额定值是以VSS为参考的，电流参数以流入端口为正，环境温度为25℃。

符号	定义	最小	最大	单位
V_B	高侧浮动电源电压	$V_S + 10$	$V_S + 20$	V
V_S	高侧浮动地电压	-9	700	
V_{HO}	高侧输出电压	V_S	V_B	
V_{CC}	低侧供电电压	10	20	
V_{LO}	低侧输出电压	0	V_{CC}	
V_{IN}	逻辑输入电压	0	V_{CC}	
T_A	环境温度	-40	125	$^\circ\text{C}$

5.6 电气特性

无特殊情况说明的情况下 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = V_B = 15\text{V}$, $C_L = 1\text{nF}$ 。

5.6.1 动态参数特性

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
t_{ON}	开通传输延时	—	530	700	ns	$V_S = 0$
t_{OFF}	关断传输延时	—	130	220		$V_S = 0\text{V or } 700\text{V}$
t_{sd}	shutdown 信号传播延时	—	130	220		
t_R	开启上升时间	—	10	35		$V_S = 0\text{V}$
t_F	关闭下降时间	—	10	35		
DT	死区时间	280	400	520		
MT	延迟匹配时间(t_{ON} , t_{OFF})	—	—	50		
MDT	死区时间匹配时间	—	—	60		

5.6.2 静态参数特性

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V_{CCUV+}	V_{CC} 欠压正向阈值	8	8.9	9.8	V	
V_{CCUV-}	V_{CC} 欠压负向阈值	7.4	8.2	9.0		
$V_{CCUVHYS}$	V_{CC} 欠压迟滞	—	0.7	—		
V_{BSUV+}	V_{BS} 欠压正向阈值	8	8.9	9.8		
V_{BSUV-}	V_{BS} 欠压负向阈值	7.4	8.2	9.0		
$V_{BSUVHYS}$	V_{BS} 欠压迟滞	—	0.7	—		
I_{LK}	高侧浮动电源泄漏电流	—	—	50	μA	$V_B = V_S = 700\text{V}$
I_{QBS}	V_{BS} 静态电流	—	50	100		$V_{IN} = 0\text{V or } 5\text{V}$
I_{QCC}	V_{CC} 静态电流	—	150	240		
V_{IH}	高电平输入阈值电压	2.5	—	—	V	$V_{CC} = 10 \sim 20\text{V}$
V_{IL}	低电平输入阈值电压	—	—	0.8		
V_{OH}	电源与输出高电平之差	—	—	1.4		
V_{OL}	输出低电平与地之差	—	—	0.1		
I_{IN+}	逻辑“1”输入偏置电流	—	25	60	μA	$I_N = 5\text{V}$
I_{IN-}	逻辑“0”输入偏置电流	—	—	2		$I_N = 0\text{V}$
I_{SD+}	输入偏置电流	—	25	60		$\overline{SD} = 5\text{V}$
I_{SD-}	输入偏置电流	—	0	2		$\overline{SD} = 0\text{V}$
I_{O+}	输出高短路脉冲电流	1.4	4.0	—	A	$V_O = 0\text{V}$ $PW \leq 10\mu\text{s}$
I_{O-}	输出低短路脉冲电流	1.8	4.0	—		$V_O = 15\text{V}$ $PW \leq 10\mu\text{s}$

6 功能描述

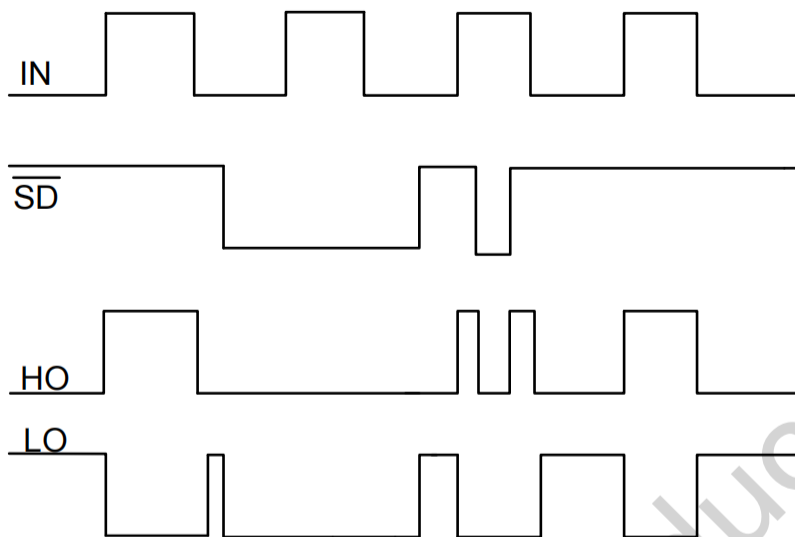


图6-1 TF2184M-TR输入输出时序波形

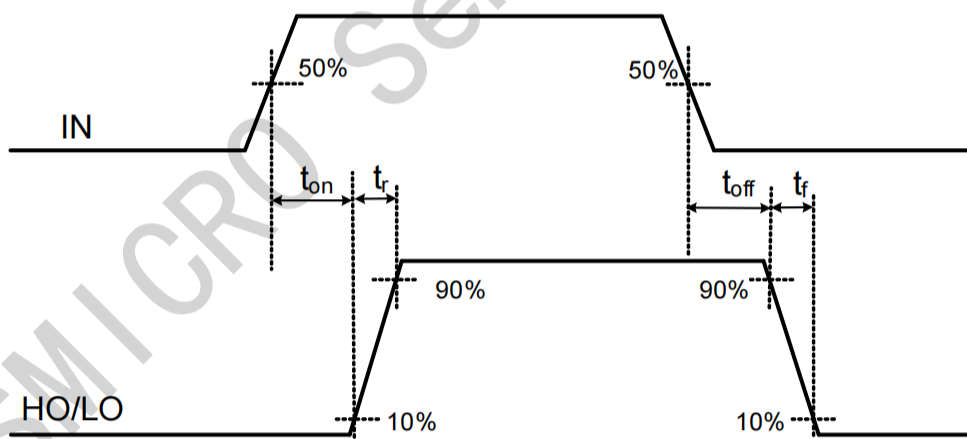


图6-2 传输时间波形定义

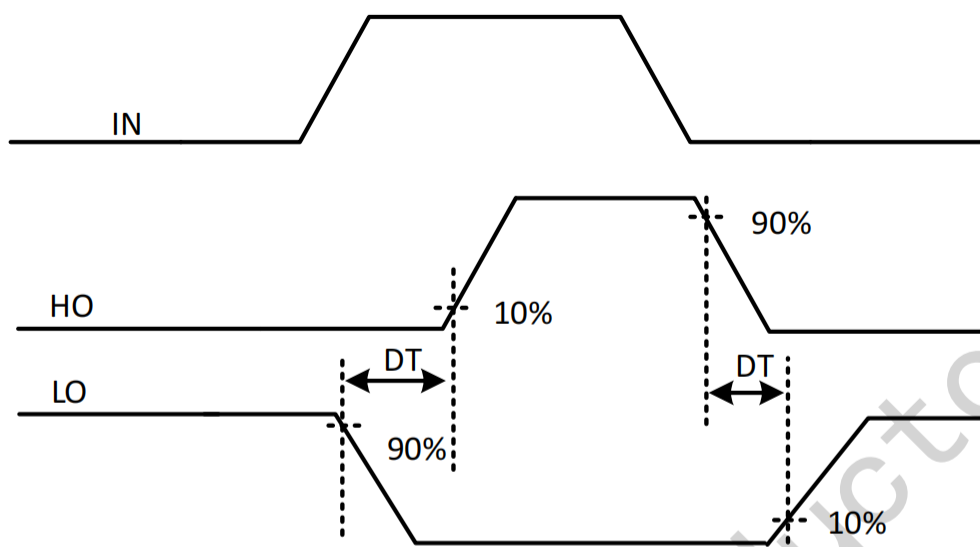


图6-3 防直通死区时间波形定义

7 TF2184M-TR说明

7.1 功能框图

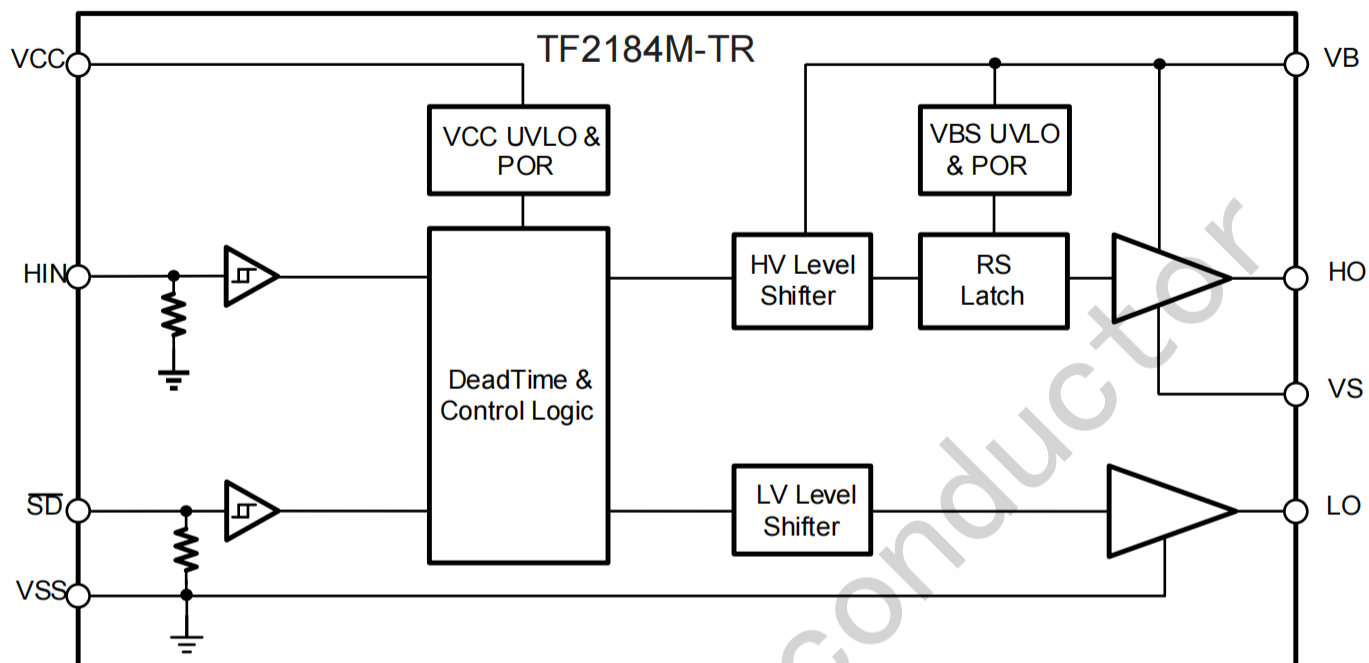


图7-1 TF2184M-TR功能框图

7.2 典型应用电路

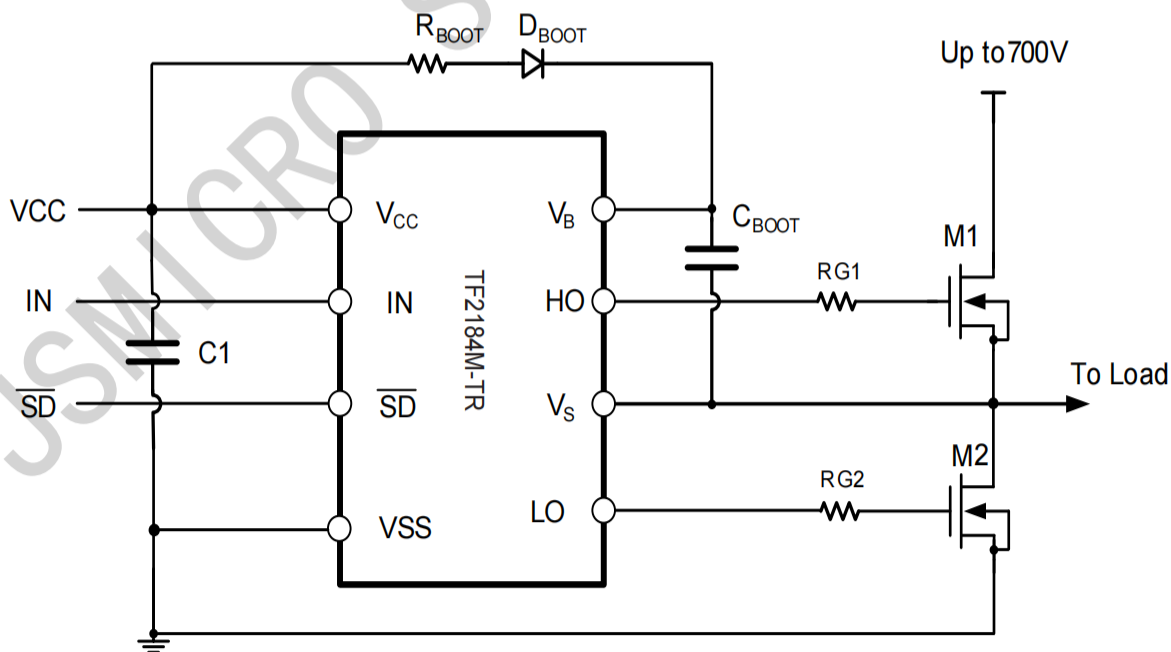
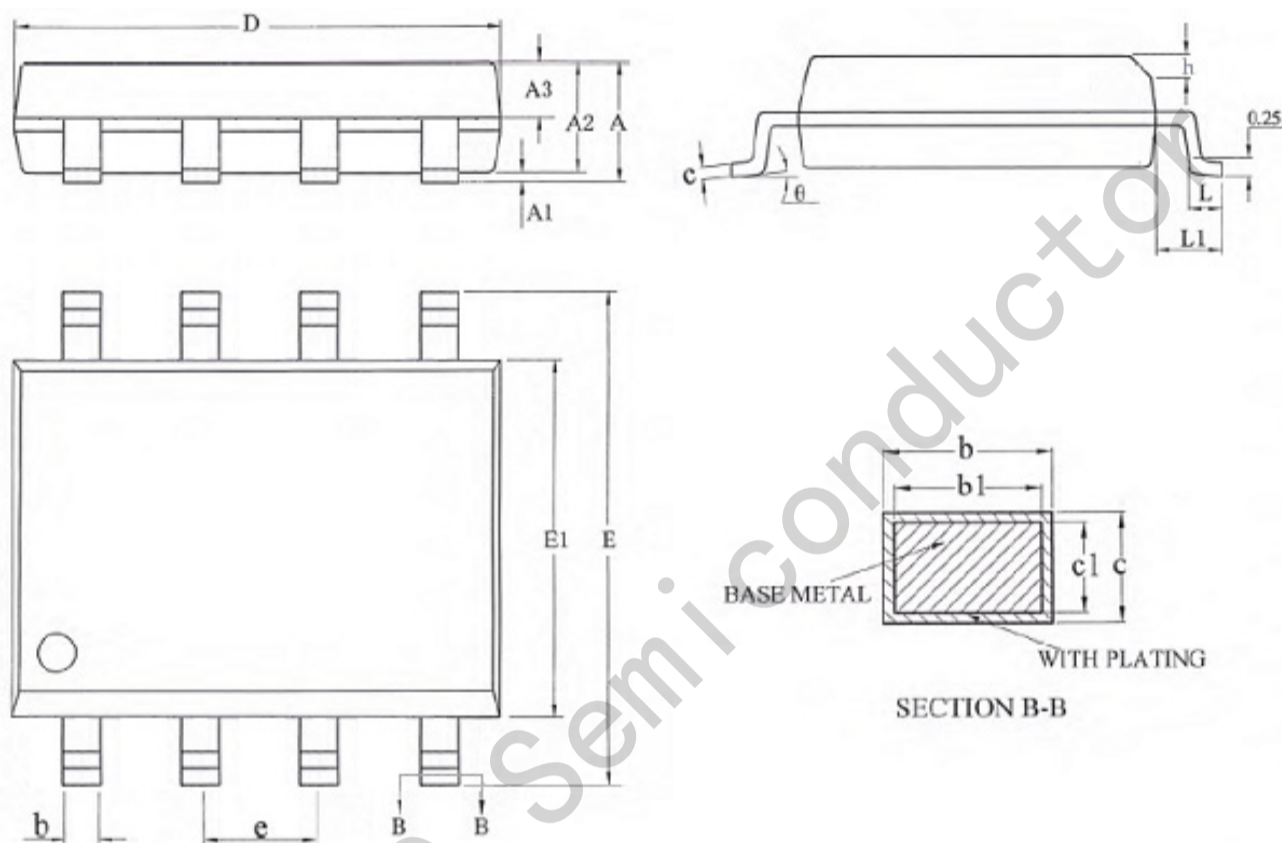


图7-2 典型应用电路图

8 封装信息

SOIC-8 Package Outlines



SOIC-8 Package Dimensions

Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)	Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)
A	-	-	1.75	D	4.70	4.90	5.10
A1	0.10	-	0.225	E	5.80	6.00	6.20
A2	1.30	1.40	1.50	E1	3.70	3.90	4.10
A3	0.60	0.65	0.70	e	1.27BSC		
b	0.39	-	0.48	h	0.25	-	0.50
b1	0.38	0.41	0.43	L	0.50		
c	0.21	-	0.26	L1	1.05BSC		
c1	0.19	0.20	0.21	θ	0	-	8°